

公司代码：688120

公司简称：华海清科



华海清科股份有限公司
2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险，审慎作出投资决策。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,083,724,706.34元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为2,988,971,069.13元，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股，不送红股。

以截至2025年12月31日总股本353,651,991股扣除回购专用证券账户中股份数954,151股测算，共计拟派发现金红利141,079,136.00元(含税)，占2025年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为13.02%；共计转增141,079,136股，转增后公司总股本增加至494,731,127股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和转增比例不变，调整拟分配的利润总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	华海清科	688120	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈圳寅	王旭
联系地址	天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号	天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号
电话	022-59781962	022-59781962
传真	022-59781796	022-59781796
电子信箱	ir@hwatsing.com	ir@hwatsing.com

注：公司于 2025 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈圳寅先生为公司董事会秘书，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事半导体专用装备的研发、生产、销售及技术服务，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于专用设备制造业（行业代码：C35）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造（行业代码：C3562）。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1、新一代信息技术产业”中“1.2.1 新型电子元器件及设备制造-3562*半导体器件专用设备制造”。

公司是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体装备供应商，主要产品包括 CMP 装备、减薄装备、离子注入装备、划切装备、边缘抛光装备、湿法装备、晶圆再生、关键耗材与维保服务等，已广泛应用于集成电路、先进封装、大硅片、第三代半导体、MEMS、MicroLED 等制造工艺，基本实现了“装备+服务”的平台化战略布局。

一、半导体装备

1、CMP 装备



CMP 装备是前道晶圆制造及先进封装等过程中实现晶圆全局平坦化的核心装备，通过化学腐蚀作用和机械研磨动态耦合，实现晶圆表面不同材料去除，从而达到纳米级全局平坦化，是光刻、刻蚀、薄膜等前道关键制造工艺能够重复进行的重要前提。同时，CMP 作为先进封装（含 3D IC、HBM、CoWoS 等）的关键工艺，贯穿键合表面制备、晶圆背减、TSV 金属化全流程，其工艺控制直接决定键合良率、电性能与机械稳定性。因此，CMP 装备是集成电路从成熟制程向先进制程迭代、先进封装技术落地不可或缺的关键设备。

公司 CMP 装备凭借自主知识产权打破国际垄断，构建了覆盖 12 英寸、8 英寸等全系列产品矩阵，是国内极少数实现 12 英寸 CMP 装备规模化量产的企业。公司 12 英寸产品全面覆盖先进制程与成熟制程，集成创新型抛光系统、多维度光学终点检测及高效清洗单元，可适配逻辑芯片、存储芯片、大硅片制造及 3D IC、HBM、CoWoS 等先进封装场景，其中面向行业前沿研发的全新 12 英寸 CMP 装备 Universal-S300，采用创新叠层布局架构，显著提升空间利用率与产能，配合高效传输与清洗系统，实现了工艺稳定性与生产效率的业界领先水平；8 英寸及以下产品兼容硅、化合物半导体等多种材质，精准匹配第三代半导体、MEMS、MicroLED 等差异化抛光需求；面板抛光装备具备先进封装基板、玻璃基板等超大尺寸工件的超平坦化加工需求，集成适配专用抛光模块与洁净处理单元，可满足先进封装领域对基板类产品的超高平整度加工要求。

2、减薄装备



减薄装备是集成电路先进封装等工艺制造所需的超精密加工高端装备，通过超精密磨削、抛光等工艺对晶圆背面进行精准材料去除与厚度修整，实现晶圆厚度从数百微米向数十微米级的精准调控，是提升芯片堆叠密度、散热性能的关键工艺设备，为后续封装、堆叠等工艺提供适配性基础，是支撑先进封装、高密度芯片堆叠等技术实现的核心工艺装备。

公司依托在 CMP 装备领域的长期技术深耕与工艺积累，成功开发适用于先进封装领域和前置晶圆制造背面减薄工艺的减薄装备。其中，全球首创的超精密减薄抛光一体机 Versatile - GP300 集成磨削减薄、化学机械抛光与清洗模块一体化设计，满足 3D IC 制造、先进封装等领域中晶圆超精密减薄技术需求；减薄贴膜一体机 Versatile - GM300 采用新型布局，可实现薄型晶圆背面超精密磨削与应力去除，兼容 8/12 英寸晶圆，完美适配 Wafer to Wafer (W2W) 和 Die to Wafer (D2W) 两种主流先进封装工艺路线；面向先进存储的高性能减薄机 Versatile-GH300 集成了业界领先的超精密磨削技术，可稳定实现亚微米级加工精度，TTV 和 WPH 行业领先。公司减薄装备可广泛覆盖硅、玻璃等多种衬底的键合晶圆减薄，适配 3D IC、CoWoS、3D NAND、高带宽内存（HBM）、图像传感器（CIS）、TSV、SOI 等多领域关键工艺需求。

3、离子注入装备



离子注入装备是集成电路前道制造的核心工艺设备，通过离子源产生高能离子束，经筛选、加速后精准注入半导体材料晶格，实现导电类型与电阻特性的精准调控，是逻辑芯片、存储芯片、功率半导体等产品制造不可或缺的关键装备。该装备技术涉及高压电子、等离子体物理等多学科交叉，行业壁垒极高，国产化替代空间广阔。

作为公司平台化战略的核心增长极，公司通过收购芯崙公司实现离子注入技术跨越式布局，依托技术自主研发与整合，持续完善产品体系。目前已成功实现 12 英寸大束流离子注入机各型号的全覆盖，并加速推出高能离子注入机系列装备，可满足逻辑芯片、存储芯片、功率半导体、CIS（图像传感器）及硅片制造等多领域工艺需求，陆续批量发往集成电路制造领域龙头企业，获得市场高度认可，成功进入规模化应用提速阶段。其中，iPUMA-LE 大束流离子注入机采用先进束流爬坡技术，离子筛选精准度高，适配逻辑芯片、存储芯片量产需求；iPUMA-LT 低温离子注入机配备耐低温静电载盘与国产化温控系统，可实现工艺温度精准闭环控制；iPUMA-HP 氢离子大束流离子注入机搭载高效粒子筛选与冷却模块，满足多种制程技术需求。

4、划切装备



边缘修整装备是半导体制造领域的超精密加工装备，通过精准切割、磨削等工艺，对晶圆边缘及倒角区域进行整形处理，去除前道工序产生的崩边、毛刺、损伤层及污染物，优化晶圆边缘形貌与尺寸精度，降低边缘缺陷对后续堆叠、划切、封装等工艺的干扰，是保障晶圆加工良率与芯片可靠性的关键配套装备，广泛应用于先进封装、CIS、存储芯片等高端制程。

为解决晶圆减薄过程中易出现的边缘崩边行业痛点，公司针对性研发形成覆盖 12 英寸、8 英寸晶圆的边缘修整装备系列。装备集成切割、传输、清洗及量测一体化单元，配置高速高扭矩主轴控制、高分辨率视觉对准与测量、高精度多轴联动切割、全自动传输及高洁净度清洗等先进技术，可有效解决存储芯片、CIS、先进封装等多种工艺场景下晶圆减薄时的边缘崩边问题，工艺适配性与加工稳定性优势显著。

5、边缘抛光装备



边缘抛光装备是半导体晶圆精密加工领域的关键装备，专注于晶圆边缘及倒角区域的超精密抛光处理，通过化学机械抛光、机械研磨等复合工艺，消除晶圆切割、减薄等前道工序产生的边缘损伤层、微裂纹、崩边及表面污染物，精准优化边缘倒角角度、圆弧半径与表面粗糙度，提升晶圆机械强度与结构完整性，为后续堆叠、封装、划切等工艺提供高可靠性基础，是先进封装、高端存储芯片等制程中保障良率的核心装备。

公司依托多年 CMP 工艺技术积淀，开发形成覆盖 12 英寸主流制程的边缘抛光装备系列。该系列装备可实现晶圆缺口、上下晶边及斜面的精准抛光，通过优化边缘形貌缺陷、去除损伤层并改善应力分布，有效提升晶圆加工良率，能够满足半导体制造领域对高精度边缘处理的严苛技术要求，适配存储芯片、逻辑芯片、先进封装等多领域核心制程需求。

6、湿法装备



湿法装备是半导体制造全流程的关键支撑装备，公司产品涵盖清洗装备与供液系统，其中清洗装备通过化学清洗、物理清洗等复合工艺，去除晶圆表面颗粒污染物，为各核心制程提供超高洁净度基底；供液系统则为湿法工艺提供研磨液、清洗液等化学品的精准配比、稳定输送。

公司在 CMP 整机装备、成套工艺等贯穿式研究过程中，掌握了纳米颗粒超洁净清洗相关核心技术，达到国内领先水平。基于该领域技术积淀及集成电路客户核心需求，公司积极开展清洗装备研发，已形成覆盖大硅片、化合物半导体等多个制造领域的系列清洗装备布局，可满足不同材质、不同制程的洁净度处理需求。同时，配套湿法工艺的 SDS/CDS 供液系统，专注于研磨液、清洗液等化学品的精准供应，具备模块化设计、灵活扩容及高精度控制优势，适配多场景湿法工艺需求。

二、半导体服务

1、关键耗材与维保服务

关键耗材与维保服务是半导体装备全生命周期运行的重要支撑，核心包括对装备运行过程中需定期更换的易损零部件、功能性材料等进行销售供应及配套维保服务，通过及时更换损耗部件、开展全流程技术保障，确保半导体装备稳定运行、延长使用寿命、维持工艺精度，是半导体制造产线高效运转的不可或缺配套环节。

公司依托核心装备（CMP 装备、减薄装备等）的长期技术积淀与庞大装机基数，构建了深度适配自有装备的关键耗材与维保服务体系。CMP 装备、减薄装备均属于运动损耗及材料消耗较多的半导体工艺设备，在运行过程中会产生大量耗材与零部件消耗，其中 CMP 装备专用核心易损部件包括抛光头、保持环等，减薄装备专用核心易损部件包括砂轮等，此类部件需按运行周期定期更换以保障设备稳定性能，形成持续且刚性的市场需求。

2、晶圆再生

晶圆再生业务是对集成电路制造过程中使用的控片、挡片等晶圆进行回收，通过去膜、研磨、抛光、高洁净清洗、严格检测等全流程工艺，去除表面薄膜、金属杂质与颗粒残留，恢复晶圆表面平整度与洁净度，使其达到循环使用标准的绿色低碳服务，是帮助客户降低耗材采购成本、提升供应链韧性的重要解决方案。

公司以自有 CMP 装备和清洗装备为核心技术依托，精准对接下游客户生产线控片、挡片的晶圆再生需求，积极拓展晶圆再生业务，已发展成为具备 Fab 级装备及工艺技术服务能力的专业晶圆再生代工厂。公司采用先进的 CMP 研磨工艺，有效提升再生晶圆的循环使用次数与稳定性，产品质量与服务能力获得客户高度认可，可满足 8/12 英寸多规格、多制程晶圆的再生需求。

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要从事半导体专用装备的研发、生产、销售及技术服务，通过向下游集成电路制造商及科研院所等客户销售 CMP、减薄、离子注入、划切、边抛及湿法等半导体装备，并提供关键耗材与维保、升级等技术服务和晶圆再生业务来实现收入和利润。

2、研发模式

公司主要采取自主研发模式，取得了 CMP 装备、减薄装备、划切装备、边缘抛光装备、湿法装备等关键核心技术领域的重要成果；同时通过收购芯崙公司实现对离子注入核心技术的吸收和转化。集成电路装备研发难度极高，按照国际行业惯用研发模式，公司的产品研发及商品化流程主要包括规划和概念阶段、设计阶段、开发实现阶段（Alpha 和 Beta）、验证确认阶段、量产及生命周期维护阶段。

3、采购模式

公司采购的主要原材料包括机械标准件类、机械加工类、气体/液体控制类、电气类和机电一体类等，其中机械加工类是供应商依据公司提供的图纸自行采购原材料并完成定制加工的零部件。其他常规标准零部件，公司面向市场进行独立采购。为保证公司产品的质量和性能，公司制定了严格的供应商选择和审核制度。公司会根据主生产计划、物料 BOM 清单和零部件的库存量，动态计算和更新零部件的采购计划，并按照采购计划在《合格供应商名录》中选择供方并进行采购。采购物资送达后，质量部进行到货检验，检验合格后由库房部办理入库手续，完成采购。

4、生产模式

公司产品均根据客户差异化需求进行定制化设计与生产制造，采用以订单式生产为主、库存

式生产为辅的生产模式。订单式生产为公司核心生产方式，在与客户签订正式订单、明确技术参数及交付要求后，按客户需求开展专属定制化设计、零部件投产、整机装配与全流程检测，确保产品精准匹配客户的个性化应用场景。库存式生产作为辅助补充模式，主要依托装备模块化设计优势，针对通用标准模块及具备明确采购预期的机型进行提前预生产；待正式订单下达后，快速调用已备货的通用模块，同步完成定制化模块的设计与生产，最终实现总装、测试与交付。

5、销售模式

公司主要通过直销模式销售产品，与潜在客户商务谈判或通过招投标等方式获取订单，公司设有市场营销部负责市场开发、产品的销售，同时客户服务中心的服务工程师在客户所在地驻场工作，负责公司产品的安装、调试、保修、维修、技术咨询。同时，公司也从事 CMP、减薄及离子注入等装备有关的耗材、配件销售以及相关技术服务，对于客户的设备耗材、备件以及维保、工艺测试、设备升级、晶圆再生等服务需求，公司在与之签订相关合同或订单后，协调公司有关部门完成相关发货、安装、测试等。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

人工智能、AI 算力、高性能计算、新能源汽车等下游产业需求的持续爆发，成为驱动全球半导体行业发展的核心引擎，叠加 5G、物联网、数据中心等下游场景的持续扩容，全球半导体产业对先进制程逻辑芯片、高端存储芯片、算力芯片及先进封装的需求呈指数级增长。在新质生产力的拉动下，全球半导体芯片领域掀起新一轮投资热潮，直接推动半导体专用设备制造行业进入高速增长黄金周期。

根据国际半导体产业协会（SEMI）发布的《年终总半导体设备预测报告》，预计 2025 年全球半导体制造设备总销售额同比增长 13.7%至 1330 亿美元，远超 2024 年 1,043 亿美元的纪录，创下历史新高，2026 年、2027 年有望继续攀升。这一增长主要得益于人工智能相关投资的强劲拉动，尤其是在尖端逻辑电路、存储器以及先进封装技术领域的设备需求爆发式增长。从区域市场来看，中国大陆连续第 10 个季度稳居全球最大半导体设备市场，成为全球市场增长的核心动力。

半导体行业跨微电子、精密机械、电气、材料、化学工程、流体力学、自动化、图像识别、软件系统、等离子物理等多学科，融合超精密运动控制、纳米级平坦化、超洁净、微粒污染控制、智能化工艺闭环等尖端技术，技术壁垒、客户认证壁垒、供应链壁垒显著。前道制造设备包括光刻、刻蚀、薄膜沉积、离子注入、化学机械抛光(CMP)、清洗、涂胶显影等关键装备，是技术壁垒最高、资本投入最大、验证周期最长的环节。随着制程向 2nm 及以下演进，高精度、高一致性、

低损伤、高产能成为设备升级的主要方向。全球供应链重构与自主可控战略深化，为本土设备企业提供明确替代机遇，关键装备国产化进入规模化兑现期。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主要产品包括 CMP 装备、减薄装备、离子注入装备、划切装备、边抛装备等集成电路专用装备及相关技术服务，产品应用覆盖集成电路前道晶圆制造、先进封装等核心环节。

在前道晶圆制造环节，公司 CMP 装备已打破国际厂商垄断，产品广泛应用于逻辑、3D NAND、DRAM 等主流工艺平台；先进制程机型出货量增长显著，已通过多家头部晶圆厂全流程工艺验证，量产能力持续提升，在国内 12 英寸先进生产线的覆盖率与市场占有率持续提升，占据国产 CMP 装备销售 90%以上份额。离子注入装备产业化加速推进，出货量快速增长，规模化应用成效显著，营业收入和新签订单均同比大幅增长；湿法清洗装备顺利通过客户验证并实现批量销售，形成具有差异化优势的国产替代解决方案。

在先进封装领域，公司 CMP、减薄装备、划切装备、边抛装备市场需求快速提升并实现批量交付，在 3D IC 等关键工艺环节完成从技术突破到规模化应用的跨越，构建起覆盖切、磨、抛全流程的成套工艺解决方案，为国内先进封装产业提供了关键高端装备支撑。公司部分先进制程 CMP 装备进入头部存储厂商 HBM 产线作为基线设备；公司全球独创的减薄抛光一体机荣获好设计金奖，累计出货量超过 20 台，在客户端表现优异，获得多家头部企业的重复订单。

在其他业务领域，公司晶圆再生业务依托技术实力与稳定服务能力，获得多家头部晶圆厂批量长期订单并实现稳定供货，客户合作粘性持续增强；天津厂区 20 万片/月已满产，并启动建设产能 40 万片/月的昆山厂区，进一步巩固国内市场领先地位。随着下游需求持续回暖、产线利用率保持高位，叠加公司 CMP 等核心装备在客户端的保有量稳步提升，关键耗材及维保服务业务需求持续释放，市场空间不断拓展。

报告期内，公司以 CMP 装备为核心支柱，以减薄、离子注入、划切、清洗等装备为重要增长引擎，产品矩阵持续完善，客户覆盖深度与广度不断提升，平台化布局成效显著。伴随国内半导体产业自主可控进程加快与下游产能持续扩张，公司在半导体专用设备领域的综合竞争力与行业影响力稳步提升，为长期高质量发展奠定坚实基础。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

集成电路产业向先进化、结构化迭代，化学机械抛光（CMP）作为核心平坦化技术，应用场景持续拓宽，已从逻辑、存储、大硅片等领域延伸至先进封装、三维堆叠等领域，成为支撑芯片

制程微缩和立体互连的关键环节。随着芯片制程不断微缩，线路密度持续增加且复杂化，推动 CMP 技术向高效化、精细化、智能化等新业态发展。未来，随着半导体产能持续扩张，CMP 技术的产业重要性与投资占比将持续提升，国产替代进程加速，形成技术自主可控新模式。公司将加大 CMP 核心技术研发投入，聚焦精度与智能化升级，迭代升级现有机型，持续推进国产替代，巩固行业优势。

离子注入领域迎来技术升级与需求扩容，作为集成电路前道制造的核心环节，其直接影响芯片性能与良率。随着芯片设计复杂度提升，推动离子注入机向高端化、定制化新业态发展，SOI 等特殊工艺也催生了新型设备需求，传统离子注入设备已难以满足高端芯片制造需求。未来，行业将形成“设备+耗材+服务”一体化新模式，国产离子注入技术有望加速突破国外垄断，实现高端领域进口替代。公司将聚焦高端定制化研发方向，加快新型离子注入设备落地投产，拓展“装备+服务”一体化布局，精准对接市场需求，抢抓国产替代机遇，提升在该领域的市场竞争力。

先进封装、化合物半导体作为集成电路产业的新增长极，受益于人工智能、智能汽车、物联网、5G 通信等下游新兴产业的快速发展，正迎来爆发式发展机遇。Chiplet、2.5D/3D IC、扇外型封装等先进封装新技术快速迭代，成为提升芯片性能、降低功耗、缩小体积的核心路径，尤其 AI 大模型的快速发展带动算力芯片需求激增，进一步推动硅中介层、RDL 等先进封装技术的广泛应用。与此同时，在高频、大功率、耐高温等应用场景的驱动下，以 SiC、GaN 等为代表的化合物半导体市场规模持续扩大，带动相关加工设备技术不断升级，封装配套设备逐步向高精度、高产能、多工艺兼容的新业态发展。公司将持续深耕先进封装与化合物半导体配套设备领域，优化现有产品性能，提升工艺适配性，强化各产品线技术协同，精准把握行业爆发式增长机遇，拓展新的利润增长点。

当前国际贸易环境复杂，半导体产业链供应链面临诸多不确定性，全球半导体产业正加速重构，呈现“自主可控、协同发展”的新业态。美国持续升级半导体领域出口管制规则，不断扩大管制范围，推动国内半导体产业加快核心技术自主研发与供应链国产化替代进程，行业逐步形成“自主研发+协同配套”的新模式，产业链上下游企业协同创新、抱团发展的趋势日益明显。公司将持续深化核心零部件自主研发，加大关键技术攻关力度，培育优质国内供应商体系，构建稳定、安全、可控的供应链，不断提升抗风险能力，同时积极参与产业链协同发展，助力国内半导体产业实现自主可控、高质量发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	13,138,674,514.44	11,750,821,583.13	11.81	9,117,359,632.14
归属于上市公司股东的净资产	7,458,493,306.42	6,473,073,313.93	15.22	5,517,735,976.37
营业收入	4,648,227,726.05	3,406,228,610.47	36.46	2,507,991,057.37
利润总额	1,198,123,572.35	1,118,287,950.42	7.14	789,834,653.41
归属于上市公司股东的净利润	1,083,724,706.34	1,023,407,865.85	5.89	723,746,551.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	964,817,514.21	856,177,230.88	12.69	608,121,136.27
经营活动产生的现金流量净额	799,821,228.42	1,154,609,605.58	-30.73	652,931,193.42
加权平均净资产收益率(%)	15.52	17.04	减少1.52个百分点	14.11
基本每股收益(元/股)	3.08	2.91	5.84	2.05
稀释每股收益(元/股)	3.07	2.90	5.86	2.05
研发投入占营业收入的比例(%)	11.69	11.56	增加0.13个百分点	12.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	912,498,331.19	1,037,093,744.55	1,244,203,445.71	1,454,432,204.60
归属于上市公司股东的净利润	233,417,322.55	272,008,804.32	285,996,698.71	292,301,880.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	212,165,322.66	248,237,094.39	262,550,270.92	241,864,826.24
经营活动产生的现金流量净额	12,916,712.88	382,057,916.67	29,519,005.37	375,327,593.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							19,779
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							15,265
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）							0
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
清控创业投资有限公司	32,708,614	99,460,887	28.12	-	无	0	国有法人
路新春	3,589,751	17,682,399	5.00	-	无	0	境内自然人
天津科海投资发展有限公司	3,753,623	11,685,507	3.30	-	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	445,109	9,677,591	2.74	-	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	3,236,448	9,180,079	2.60	-	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,116,859	8,833,793	2.50	-	无	0	其他
雒建斌	2,159,026	8,164,947	2.31	-	无	0	境内自然人
清津厚德（济南）科技合伙企业（有限合伙）	-7,987,103	7,346,024	2.08	-	无	0	境内非国有法人
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯 片交易型开放式指数证券投资基金	2,562,491	5,621,790	1.59	-	无	0	境内非国有法人

招商证券资管—朱煜—招商资管臻享价值 2023031号单一资产管理计划	401,216	4,152,678	1.17	-	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东是否有关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

注：2025年，路新春先生通过大宗交易方式减持公司部分股份，本次权益变动后，其直接持有公司股份17,682,399股，占公司总股本353,651,991股的4.9999%，持股比例降至5%以下。

存托凭证持有人情况

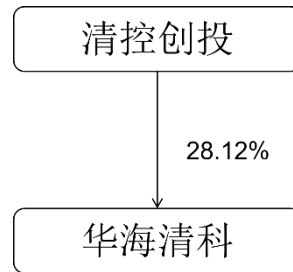
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

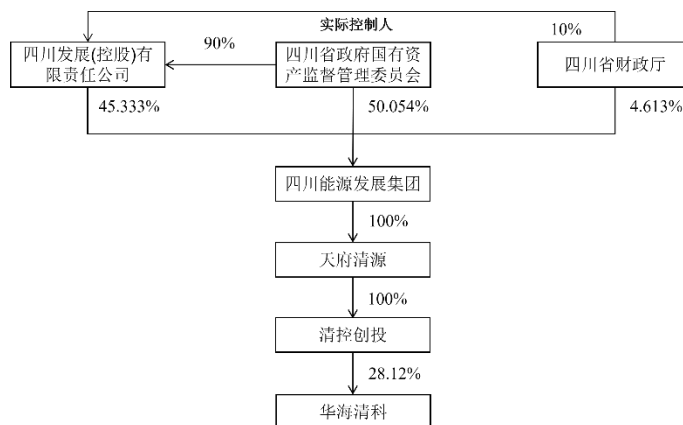
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参考第三节“四、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用